BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



REC'D **0 3 JUL 2003**WIPO PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 17 139.4

DOCUMENT

PRIORITY

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Anmeldetag:

17. April 2002

Anmelder/Inhaber:

Prof. Dr. Norbert A u n e r , Frankfurt am Main/DE

Bezeichnung:

Verfahren zur Herstellung von Halosilanen

IPC:

C 07 F, B 01 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 7. Mai 2003

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Dzierzow

A 9161 02/00 EDV-L 11/04/2002 IN:38

Prof.Dr. Norbert Auner Marie-Curie-Str. 11 60439 Frankfurt am Main

5

Anwaltsakte: Dn-2728

Düsseldorf, den 17.04.2002

10

15

Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Halosilanen durch Umsetzung von Silicium mit einem Halogen oder einer Halogenverbindung beschrieben. Dabei wird das Silicium mit einer Gasatmosphäre des Halogens oder der Halogenverbindung kontaktiert und mit Mikrowellenenergie beaufschlagt. Auf diese Weise lassen sich Halosilane mit einem geringen Energieaufwand herstellen.

20

Prof.Dr. Norbert Auner Marie-Curie-Str. 11 60439 Frankfurt am Main

5

Anwaltsakte: Dn-2728

Düsseldorf, den 17.04.2002

10

Verfahren zur Herstellung von Halosilanen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Halosilanen durch Umsetzung von Silicium mit einem Halogen oder einer Halogenverbindung.

15

20

Ein wichtiger Vertreter der Halosilane ist das Siliciumtetrachlorid (Tetrachlorsilan), bei dem es sich um eine wasserhelle, farblose, leicht bewegliche, erstickend riechende, an der Luft rauchende Flüssigkeit handelt. Siliciumtetrachlorid wird zur Herstellung von Siliconen, Silanen und Kieselsäureestern, zur Gewinnung von SiO₂, von sehr reinem Si sowie zur Oberflächenbehandlung von Polymeren und Metallen verwendet.

25

Es ist bekannt, Siliciumtetrachlorid herzustellen, indem man ein Gemisch aus geglühter Kieselsäure und Kohle im Chlorstrom erhitzt oder Ferrosilicium in Gegenwart von SiC bei 500-1.000 °C chloriert.

30

Ähnliche Verfahren finden zur Herstellung von weiteren Halosilanen Anwendung.

35

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Halosilanen anzugeben, das sich mit einem besonders geringen Energieeinsatz durchführen läßt.

25

30.

35

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einem Verfahren der angegebenen Art dadurch gelöst, daß man das Silicium mit einer Gasatmosphäre des Halogens oder der Halogenverbindung kontaktiert und mit Mikrowellenenergie beaufschlagt.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens hat sich gezeigt, daß das Silicium besser reagiert, je größer dessen Korngröße ist. So wird vorzugsweise erfindungsgemäß Silicium mit einer Korngröße von $>70~\mu\mathrm{m}$ verwendet.

Vorzugsweise wird kristallines, insbesondere grobkristallines, Silicium eingesetzt. Hierbei können auch Einkristalle, beispielsweise aus Waver-Abfallstücken, eingesetzt werden. Dies schließt jedoch nicht aus, daß auch amorphes Silicium eingesetzt werden kann. Vorzugsweise wird dieses im Gemisch mit kristallinem Silicium verwendet, wobei sich besonders gute Reaktionsergebnisse gezeigt haben.

Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens setzt man Silicium in Verbindung mit einem Katalysator/Promotor ein. Derartige Katalysatoren/Promotoren sind vorzugsweise Metalle oder Metallverbindungen, insbesondere Kupfer.

Bei einer anderen Variante setzt man Silicium in Verbindung mit einer Mikrowellenenergie absorbierenden und thermische Energie auf Silicium übertragenden Substanz ein. Diese Substanz kann gleichzeitig als Katalysator/Promotor wirken. Eine solche Substanz ist beispielsweise Kupfer.

Mit derartigen Substanzen und/oder Katalysatoren/Promotoren läßt sich insbesondere amorphes Silicium oder Silicium mit einer relativ geringen Korngröße (beispielsweise unter 70 μ m) umsetzen.

Wenn man daher davon ausgeht, daß die Reaktionsfähigkeit des Siliciums beim erfindungsgemäßen Verfahren korngrößen- abhängig ist, wird vorzugsweise bei höheren Korngrößen, beispielsweise >70 μ m, nur mit Silicium gearbeitet, während man bei geringeren Korngrößen zusätzlich entsprechende Substanzen einsetzt, die die Reaktion fördern (Katalysatoren, Promotoren, Mikrowellenenergie absorbierende Substanzen etc.).

10

Wie erwähnt, wird das Silicium zur Umsetzung mit einer Gasatmosphäre des Halogens oder der Halogenverbindung kontaktiert. Bevorzugt werden Gasatmosphären aus dem Halogen selbst oder Halogenwasserstoffverbindungen verwendet, wobei zur Herstellung von Siliciumtetrachlorid eine Chlor-Atmosphäre eingesetzt wird. Was die Halogenverbindungen anbetrifft, so können auch Organohalogenverbindungen eingesetzt werden.

15

Damit die erfindungsgemäße Umsetzung kontinuierlich abläuft, wird vorzugsweise nicht-gepulste Mikrowellenenergie eingesetzt. Zur Erzeugung der gewünschten Mikrowellenenergie kann auf bekannte Mikrowellenöfen zurückgegriffen werden.

25

Die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispieles erläutert. Das Verfahren wurde im Labormaßstab durchgeführt.

30

35

(I)

Um normale Glasapparaturen und Inertgasmethoden drucklos verwenden zu können, wurde ein modifizierter Haushaltsmikrowellenofen verwendet. Der Sicherheitskäfig des Ofens wurde an drei Stellen mit Bohrungen versehen. Diese Bohrungen hatten einen Abstand von 10 cm, wobei die mittlere Bohrung zentrisch angeordnet wurde. Um zu gewährleisten,

daß die Apparatur immer im aktiven Bereich des Ofens lag, bildeten die Bohrungen eine Linie mit der Austrittsöffnung des Magnetrons. Die normale Drehung des Tellers wurde durch Verwendung einer Keramikfliese unterbunden, die keine Verbindung zur Antriebseinheit besaß.

Um eine Freisetzung von Energie in die Umgebung zu verhindern, wurden die drei Bohrlöcher jeweils mit Hilfe eines 12 cm langen Kupfertubus abgeschirmt. Die Länge des Tubus entsprach der Wellenlänge der verwendeten Frequenz von 2.450 MHz (etwa 12 cm), die für diese Öfen obligatorisch ist. Distanzstücke aus Laborglas ermöglichten den Anschluß von üblichem Laborequipment.

- Es wurde ein Mikrowellenofen der Firma Panasonic (Modell NN-T251W) verwendet, der im Gegensatz zu Geräten anderer Hersteller bei reduzierter Leistung kontinuierlich einstrahlte und nicht pulste.
- Im Mikrowellenofen wurde ein U-Rohr angeordnet. Im U-Rohr wurde eine abgewogene Menge Silicium auf einem etwas ausgehöhlten Schamottestein vorgelegt.
- Zur Anwendung kam eine Charge von kristallinem Silicium mit einer Reinheit von 99,99 % und einer Korngröße von 70-400 μm. Nach dem Evakuieren und Belüften mit einer N₂-Atmosphäre wurde Cl₂/HCl/CH₃Cl durch die Apparatur geleitet. Das Gas durchströmte vorher noch eine Waschflasche mit H₂SO₄ konz und wurde nach der Reaktion mittels einer Kühlfalle (N₂ fl.) ausgefroren.

Nachdem die Cl₂/HCl/CH₃Cl-Atmosphäre um das Silicium herum aufgebaut worden war, wurde der Mikrowellenofen mit einer Leistung von 250 W eingeschaltet, und es wurde abgewartet, bis das Silicium unter Glühen weitgehend abreagiert hatte.

10

Dies erfolgte sowohl bei ${\rm Cl}_2$ als auch bei HCl und ${\rm CH}_3{\rm Cl}$ nach ca. 5 min. Das ${\rm Cl}_2/{\rm HCl}/{\rm CH}_3{\rm Cl}$ wurde daraufhin durch ${\rm N}_2$ ersetzt, und die Kühlfalle wurde aufgetaut.

5 In den drei Fällen liefen folgende Reaktionen ab:

0,4 g Si +
$$Cl_2(g) \rightarrow SiCl_4$$
 (isolierte Ausbeute: 1,17 g = 48,75 %)

10 0,4 g Si + $HCl_{(g)} \rightarrow HSiCl_3 + SiCl_4 + weitere$ (isolierte Ausbeute: 1,08 g = 40 % bezogen auf Si)

0,4 g Si +
$$CH_3Cl \rightarrow Me_2SiCl_2$$
 (50 %) + $MeSiCl_3$ (20 %)
+ Me_3SiCl (30 %)

Durch Verdünnen des CH₃Cl-Gases mit Argongas läßt sich die Ausbeute an Dimethyldichlorsilan noch weiter erhöhen:

20 0,4 g Si + CH_3Cl/Ar (1:1) \rightarrow Me_2SiCl_2 (71 %) + $MeSiCl_3$ (8 %) + Me_3SiCl (18 %) + Me_4Si (3 %)

Daneben werden noch geringere Menge an SiCl4 nachgewiesen.

Durch die vorstehend beschriebene Reaktion mit Methylchlorid wird eine neue direkte Synthese zur Verfügung gestellt.

Prof.Dr. Norbert Auner Marie-Curie-Str. 11 60439 Frankfurt am Main

5

Anwaltsakte: Dn-2728

Düsseldorf, den 17.04.2002

10

15

25

30

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von Halösilanen durch Umsetzung von Silicium mit einem Halogen oder einer Halogenverbindung, dadurch gekennzeichnet, daß man Silicium mit einer Gasatmosphäre des Halogens oder der Halogenverbindung kontaktiert und mit Mikrowellenenergie beaufschlagt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 man kristallines, insbesondere grobkristallines, Silicium verwendet.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man amorphes Silicium verwendet.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß man amorphes Silicium im Gemisch mit kristallinem Silicium verwendet.
 - 5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man Silicium in Verbindung mit einem Katalysator/Promotor einsetzt.
- Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, da durch gekennzeichnet, daß man Silicium in Verbindung

mit einer Mikrowellenenergie absorbierenden und thermische Energie auf Silicium übertragenden Substanz einsetzt.

- Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man als Halogenverbindung Halogenwasserstoff verwendet.
- 8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, da10 durch gekennzeichnet, daß man als Katalysator/Promotor
 Metalle oder Metallverbindungen, insbesondere Cu, einsetzt.
- Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, da durch gekennzeichnet, daß nicht-gepulste Mikrowellen energie eingesetzt wird.
 - 10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man Silicium mit einer Korngröße von $>70~\mu m$ verwendet.
 - 11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man als Halogenverbindung
 Organohalogenverbindungen, insbesondere Alkyl- oder
 Arylhalogenide, speziell Methylchlorid, verwendet.

30

20

25

5

35

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CÚT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.